

制限反応スパッタ製膜法による高誘電率YSZ絶縁膜の研究

著者	佐々木 公洋
著者別表示	Sasaki Kimihiro
雑誌名	平成14(2002)年度 科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書
巻	2001-2002
ページ	4p.
発行年	2003-06
URL	http://doi.org/10.24517/00053758



KAKEN
2002
60

金 沢 大 学

研究課題

制限反応スパッタ製膜法による 高誘電率YSZ絶縁膜の研究

(課題番号 13650338)

平成13年度～平成14年度科学研究補助金 (基盤研究(C)(2))
研究成果報告書

平成15年6月

研究代表者 佐々木 公洋

金沢大学附属図書館



0300-02165-8

金沢大学工学部助教授

KAKEN
2002
60

(別紙様式12)

研究課題

制限反応スパッタ製膜法による
高誘電率YSZ絶縁膜の研究

(課題番号 13650338)

平成13年度～平成14年度科学研究補助金 (基盤研究(C)(2))
研究成果報告書

平成15年6月

研究代表者 佐々木 公洋

金沢大学工学部助教授

研究組織

[平成13年度]

研究代表者	佐々木 公洋	(金沢大学工学部)	助教授)
研究分担者	畑 朋延	(金沢大学工学部)	教授)

[平成14年度]

研究代表者	佐々木 公洋	(金沢大学工学部)	助教授)
研究分担者	畑 朋延	(金沢大学工学部)	教授)

研究経費

平成13年度	2,500	千円
--------	-------	----

平成14年度	1,100	千円
--------	-------	----

計	3,600	千円
---	-------	----

研究発表

学会誌等

1. Kimihiro SASAKI, Kentaro KAWAI, Tatsuhiro HASU, Makoto YABUUCHI and Tomonobu HATA,
"Feasibility of Ultra-thin Films for Gate Insulator by Limited Reaction Sputtering Process",
IEICE Transactions on Electronics (to be published)
2. Kimihiro Sasaki, Tatsuhiro Hasu, Kenji Sasaki and Tomonobu Hata
"Limited Reaction Growth of YSZ (ZrO₂:Y₂O₃) Thin Films for Gate Insulator",
Vacuum **66** [3-4] (2002) pp.403-408.
3. S.Hana, R.Kanata, S.Nasir, K.Sasaki and T.Hata
"A New PZT Thin Film Preparation Technique using Solid Oxygen-Source Target by RF reactive Sputtering", Proc. Of 2002 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics, pp.378-382(2002).
4. M.Yabuuchi, Kkawai, T.Hasu, K.Sasaki and T.Hata,
"The Growth of ZrO₂ and the Gate Insulation Film Characteristic by Limited-Reaction Sputtering",
The 14th Symposium of The Material Reserach Society of Japan, Program and Abstracts p.247 (M2-P15-M) (2002).
5. K.Sasaki and T.Hata,
"Metallic Mode Growth of ZrO₂-Based Thin Films for Gate Insulator Using Reactive Sputtering Technique", 2001 AWAD, (2001) pp.93-97.
6. K.Sasaki, T.Hasu, K.Sasaki and T.Hata,
"Limited Reaction Growth of YSZ (ZrO₂:Y₂O₃) Thin Films for Gate Insulator",
Proc. of ISSP, (2001)pp.41-44.

研究会資料

1. 藪内 誠、河合 賢太郎、永田 喜也、佐々木 公洋、畑 朋延,
" 制限反応スパッタ法によるZrO₂薄膜の界面構造とゲート絶縁膜特性",
電子情報通信学会技術研究報告, SDM2003発表予定(2002).
2. 河合賢太郎, 蓮達弘, 文殊康真, 和泉亮, 佐々木公洋, 畑朋延,
" 制限反応スパッタ法によるZrO₂の成長とゲート絶縁膜特性",
電子情報通信学会技術研究報告, SDM2002-62, pp.27-31(2002).